

УДК 539.163
ЭЛЕКТРОНЫ “ВСТРЯСКИ” ПРИ β -РАСПАДЕ $^{152,154}\text{Eu}$

Н. Ф. Митрохович

Інститут ядерних ісследований НАН України, Київ

На основании измерений двойных и тройных совпадений γ -квантов и β -частиц с низкоэнергетическими электронами (включая e_0 -электроны вторичной электронной эмиссии оклонулевой энергии) - (γ, β) - (e, e_0) -совпадения - получены значения выхода e_0 -электронов от “встряски” на акт β -распада ^{152}Eu для β -компонент 175, 384, 695, 1063 кэВ. На основании измерений совпадений γ -квантов, конверсионных электронов (СЕ), β -частиц с e_0 -электронами - совпадения $(\gamma, \text{СЕ})$ - (e, e_0) и совпадения $\gamma\beta e_0$ - измерен выход e_0 -электронов от “встряски” на акт β -распада ^{154}Eu для β -компонент 249, 571, 841 кэВ ^{154}Eu . Установлено, что в β -распадах $^{152,154}\text{Eu}$ β -частицы и электроны “встряски”, наблюдаемые по создаваемым ими e_0 -электронам, скоррелированы в направлении вылета, испытывая преимущественное испускание в одну полусферу.

1. Введение

Изучение эффектов “встряски” атомной оболочки при изменении заряда ядра, например в случае α - и β -распада, или при изменении эффективного заряда в случае переходов во внутренних оболочках является важной областью исследований в атомной спектроскопии и, в частности, Оже-спектроскопии. В значительной степени это связано с возможностью изучения многоэлектронных корреляций в атомах. В ядерной физике эффекты “встряски” требуют внимания для полноты описания атомно-ядерного процесса, при измерениях или вычислениях коэффициентов внутренней конверсии (КВК) внешних оболочек, при точных измерениях формы β -спектра и вообще для учета вклада в любой физический или ядерно-физический результат, где такой вклад от “встряски” возможен [1 - 3]. Не вдаваясь в детали описания процесса, нужно в главном для дальнейшего отметить, что в приближении внезапного возмущения и простейшем варианте теории, когда дифференциальная вероятность “встряски” описывается квадратом интеграла перекрытия волновых функций, действуют монопольные правила отбора по орбитальному моменту, спектр электронов “встряски” низкоэнергетичен, а вероятность “встряски” не зависит от энергии β -частицы.

В данной работе продолжены исследования автора по “встряске” [2, 3], которые были предприняты, главным образом, с целью изучения влияния процессов “встряски” при определении КВК по e_0 -электронам вторичной электронной эмиссии от заполнении вакансии после конверсии. В проводимых исследованиях нужно определить выход e_0 -электронов от “встряски” и сам выход электронов “встряски” на акт β -распада, а также измерить корреляцию β -частицы с электроном “встряски”, что в данном контексте соответствует и общефизической задаче по “встряске”. Настоящая работа дополняет ранее полученные результаты по “встряске” при β -распаде ^{152}Eu [3] по выходу e_0 -электронов от “встряски”, по данным о корреляции β -частица - электрон “встряски”, а также дополняет в указанных выше аспектах существующие данные полученными данными по “встряске” при β -распаде ^{154}Eu .

2. Методики измерений и результаты

Измерения были проведены на двух установках: спектрометре $\pi\sqrt{2}$ с позиционно-чувствительным детектором в фокальной плоскости, оснащенным $\text{NaJ}(\text{Tl})$ каналом совпадений с γ -квантами и каналом совпадений с e_0 -электронами от источника на беспороговом (MCP) детекторе электронов (рис. 1, a) и на отдельной установке $\gamma\beta e_0$ -совпадений с $\text{Ge}(\text{Li})$ детектором (рис. 1, б).

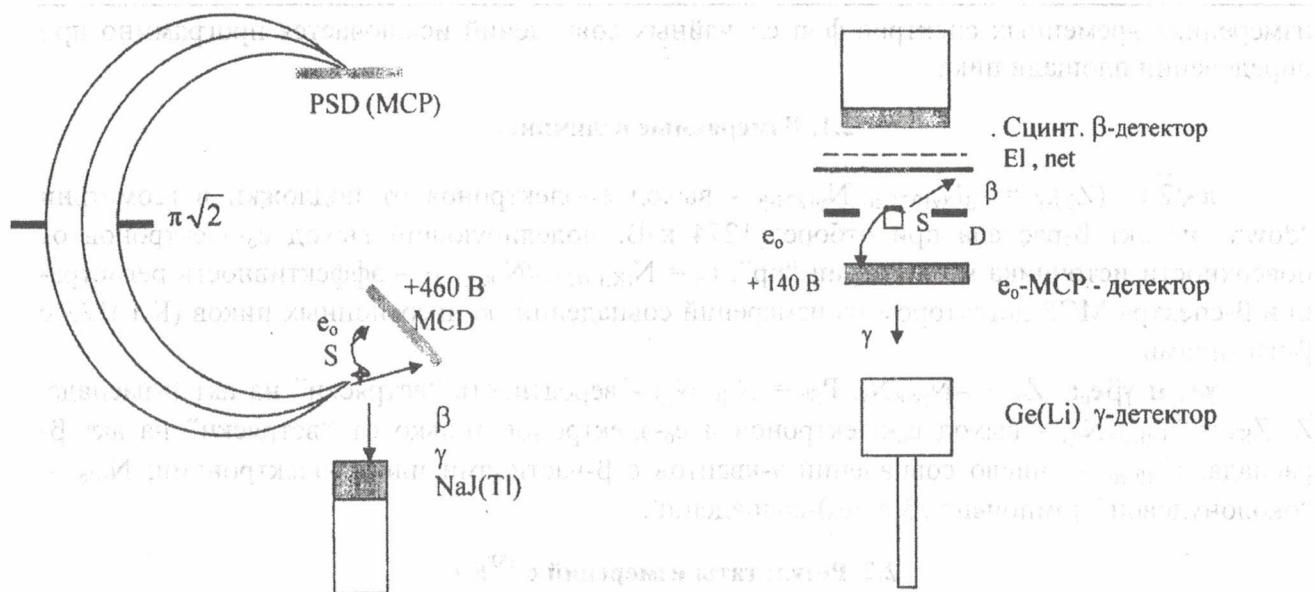


Рис. 1. Геометрии измерений совпадений конверсионных электронов (СЕ), β -частиц и γ -квантов с e_0 -электронами: а - (СЕ, $\Delta\beta_{\text{IC}}$, γ)-(е + e_0)-совпадения на магнитном β -спектрометре $\pi\sqrt{2}$ высокого разрешения с позиционно-чувствительным детектором (PSD) в фокальной плоскости и регистрацией электронного (MCP) и γ -излучения ($\text{NaJ}(\text{Ti})$) источника (S); б - γ е₀-совпадения в установке с регистрацией e_0 -электронов микроканальными пластинами (MCP), β -частиц – сцинтилляционным детектором, γ -квантов – $\text{Ge}(\text{Li})$ детектором, El-экран – Al фольга 10 мкм, net – сетка, D – диафрагма. Показана ориентация источника "up". В "down" источник ориентирован активностью к MCP.

Исследования по "встряске" при β -распаде ^{152}Eu проведены на установке (см. рис. 1, б), на которой измерялись энергетические спектры γe_0 , $\gamma\beta$ - и $\gamma\beta e_0$ -совпадений. Измерения по "встряске" при β -распаде ^{154}Eu проведены на обеих установках. Методика измерений и учета фоновых факторов подробно описана в предыдущей работе [3], а здесь излагается только в главных чертах. Как часть исследований по ^{154}Eu , на установке с $\pi\sqrt{2}$ (см. рис. 1, а) измерялись временной спектр e_0 - γ 1274 совпадений в геометрии "down" и временные спектры (K, L)123- β совпадений с конверсией γ 123 кэВ в геометрии "up". В спектре с e_0 -совпадениями выделялся задержанный компонент, поскольку задержка вылета e_0 -электронов из среды источника по физической природе присуща им, как электронам второй электронной эмиссии. Для определения выхода самих электронов "встряски" (e_{sh}) от β -распада измерялись совпадения β -частиц с сопутствующим β -распаду электронным излучением "ненулевой" области при подаче на источник небольшого (+ 60 В) запирающего по отношению к MCP-напряжения. Все измерения на обеих установках, кроме e_0 - γ 1274 на $\pi\sqrt{2}$, проведены в геометрии "up" (см. рис. 1). Касаясь фоновых факторов нужно отметить, что при измерениях энергетических спектров $\gamma\beta e_0$ -совпадений на установке с $\text{Ge}(\text{Li})$ спектрометром и определении соответствующих выходов $N_{\gamma e_0}/N_\gamma$ и $N_{\gamma\beta e_0}/N_{\beta\gamma}$ нужен был учет рассеяния из детектора MCP в β -детектор, который осуществлялся на основе измерения соответствующих эффективностей регистрации $P_{\beta e} = \varepsilon_{\beta e}/\varepsilon_e$, $\varepsilon_{\beta e} = N_{\gamma\beta e_0}/N_\gamma$, $\varepsilon_e = N_{\gamma e_0}/N_\gamma$ в различных условиях диафрагмирования источника между детекторами. Также важен учет фона случайных совпадений, который осуществлялся по чисто фоновым пикам и составлял 10 - 15 % по пикам γ 344 и γ 1274 спектра совпадений с ^{152}Eu и ^{154}Eu соответственно. При

измерениях временных спектров фон случайных совпадений исключается программно при определении площади пика.

2.1. Измеряемые величины

$\pi\sqrt{2}$: $(Z_\beta)_{sf} = \varepsilon_\beta N_{\gamma 1274-e_0}/N_{\gamma 1274-\beta}$ - выход e_0 -электронов от подложки в геометрии "down" на акт β -распада при отборе $\gamma 1274$ кэВ, моделирующий выход e_0 -электронов от поверхности источника в геометрии "up". $\varepsilon_\beta = N_{(K,L)123-\beta}/N_{(K,L)123}$ - эффективность регистрации β -спектра MCP детектором из измерений совпадений конверсионных пиков $(K,L)123$ с β -частицами.

γe_0 и $\gamma\beta e_0$: $Z_\gamma = N_{\gamma e_0}/N_\gamma$, $P_{Sh} = N_{\gamma\beta e}/N_{\gamma\beta}$ - вероятность "встряски" на акт β -распада. Z , $Z_{Sh} = N_{\gamma\beta e_0}/N_{\gamma\beta}$ - выход e_0 -электронов и e_0 -электронов только от "встряски" на акт β -распада; $N_{\gamma(\beta,e_0)}$ - число совпадений γ -квантов с β -частицами или e_0 -электронами; $N_{\gamma\beta e_0}$ - "околонулевой" компонент $\gamma\beta(e+e_0)$ -совпадений.

2.2. Результаты измерений с ^{152}Eu

Фрагмент экспериментального спектра совпадений γ -квантов с β -частицами и электронами (e_0 -электронами) для источника ^{152}Eu , содержащего примесь ^{154}Eu , приведен на рис. 2. Измерения выполнены в геометрии с сеткой, с диафрагмой и без экрана El. Источник был ориентирован подложкой к МССР-детектору (геометрия "up"). В части от ^{154}Eu в совпадениях участвуют электроны конверсии от $\gamma 123$ (IC123), электроны "встряски" (e_{Sh}), e_0 -электроны от конверсии (e_0) и e_0 -электроны от "встряски" ($(e_0)_{Sh}$). В части от ^{152}Eu пики $\gamma 1299\beta 175(e+e_0)$ -совпадений не содержат конверсионного компонента и демонстрируют (с вычитанием 12 % фона) совпадения с электронами "встряски" и e_0 -электронами от "встряски". Пунктиром (без указания статистического разброса значений для облегчения рисунка) на рисунке показан спектр $\gamma\beta$ -совпадений, на который с корректировкой на фон делятся спектры $\gamma\beta e$ - и $\gamma\beta e_0$ -совпадений для получения $(P_\beta)_{Sh}$ выхода электронов "встряски" и Z_{Sh} выхода e_0 -электронов от "встряски" на акт β -распада ^{152}Eu . Основные результаты по

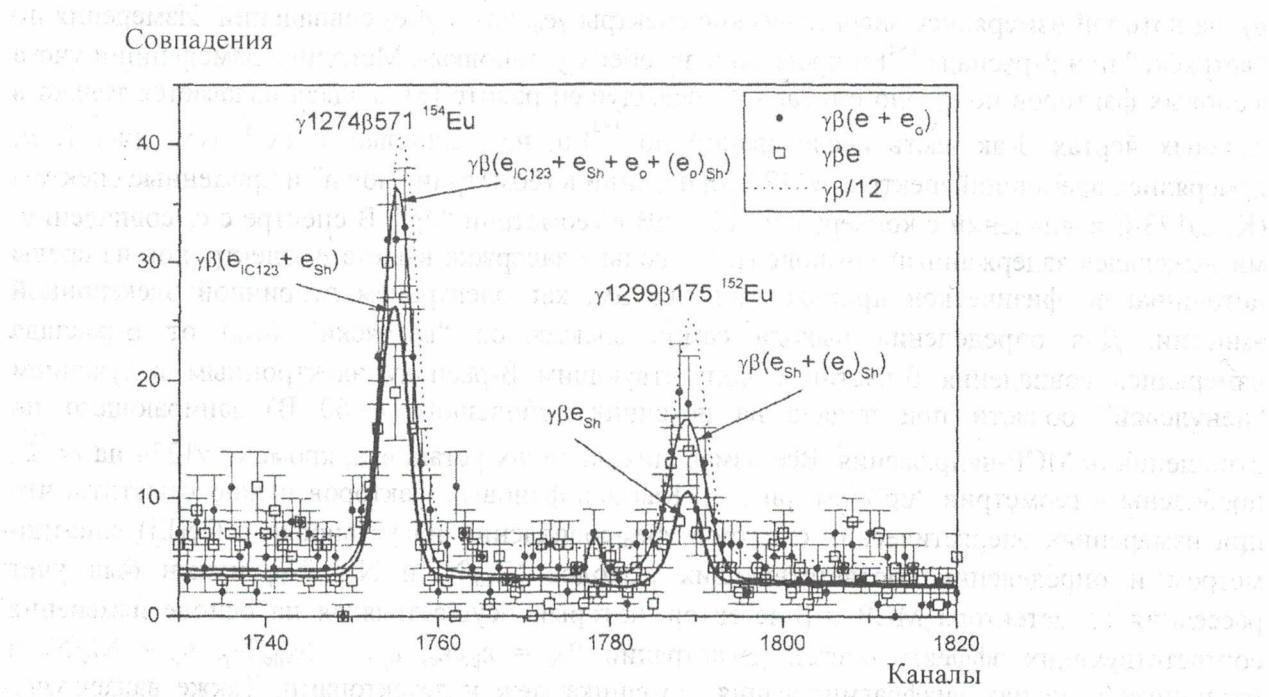


Рис. 2. $\gamma\beta(e+e_0)$ -совпадения в распаде $^{152}, ^{154}\text{Eu}$.

^{152}Eu приведены в табл. 1. Таблица содержит Z -выходы e_0 -электронов, полученные из измерения γ -, $\gamma\beta$ -, γe_0 - и $\gamma\beta e_0$ -спектров с различными потенциалами и геометриями окружения источника (сетка Net, диафрагма D, экран El, Al между источником и MCP) и относящиеся либо ко всей геометрии измерений, либо к обратной стороне источника (индекс b), либо к самой поверхности источника (индекс sf). На основании этих данных, значений эффективностей ε_β , ε_e , $\varepsilon_{\beta e}$ одиночной и совместной регистрации β -и MCP-детекторами, а

Таблица 1. Z -выходы e_0 -электронов, выход электронов "встряски" P_{Sh} и e_0 -электронов от "встряски" Z_{Sh} на акт β -распада в γe_0 - и $\gamma\beta e_0$ -совпадениях в распаде ^{152}Eu

№, эксперимент	$\beta175$ ($\gamma1299$)	$\beta384$ ($\gamma1090$)	$\beta695$ ($\gamma779$)	$\beta1063$ ($\gamma411$)	Геометрия измерений
1. γe_0	0,013(1)	0,019(1)	0,0116(4)	0,011(1)	Net, D
2. $(\gamma e_0)_b$	0,0003(16)	0,0040(26)	0,0087(8)	0,0076(19)	Al
3. $(\gamma e_0)_{sf}$	0,013(1)	0,015(3)	0,0029(8)	0,0034(22)	1 – 2, Net
4. γe_0	0,0232(6)	0,0143(6)	0,0072(2)	0,0076(4)	El
5. $(\gamma e_0)_{sf+El}$	0,0229(6)	0,0103(27)	0,000(1)	0,000(19)	4 – 2, El
6. $\gamma\beta e_0$	0,035(16)	0,024(6)	0,0130(12)	0,0087(20)	El
7. $\gamma\beta e_0$	0,0372(60)	0,0062(27)	0,0047(4)	0,0051(18)	Net, D
8. $(P_\beta)_{Sh}$	0,0416(126)	0,0353(24)	0,0272(14)	0,0205(6)	$\gamma\beta e_0 (1,57 \cdot \pi \sqrt{2})$
9. P_{MCP}	0,0420(48)	0,0305(20)	0,0335(6)	0,0376(11)	$\varepsilon_{\beta e}/\varepsilon_\beta$
10. ε_e	0,0223(5)	0,0500(15)	0,0667(4)	0,0633(8)	$N_{\gamma e}/N_\gamma$
11. $\varepsilon_{\beta e}$	0,00077(15)	0,0033(2)	0,0052(1)	0,0059(2)	$N_{\gamma\beta e}/N_\gamma$
12. $P_{\beta e}$	≈ 0	≈ 0	0,0148(3)	0,0430(15)	*
13. Z_{Sh}	0,0372(60)	0,0062(27)	0,0044(4)	0,0045(18)	**

$$* P_{\beta e} = (P_{MCP} - (P_{\Delta\beta})^{Sh} * (\varepsilon_{\beta\gamma344}/(\varepsilon_{\beta\gamma344}) * \varepsilon_{\beta e}) / P_{MCP} * \varepsilon_e.$$

$$** Z_{Sh} = Z_{\gamma\beta e_0} - 2(Z_{\gamma e_0})_b P_{\beta e}.$$

Все энергии приведены в кэВ.

также с учетом ранее полученных [3] на установке с $\pi\sqrt{2}$ выходов электронов "встряски" на акт β -распада определена вероятность регистрации MCP-детектором сопутствующего β -распаду электронного излучения (P_{MCP} , включает "встряски" + рассеяние из детектора в детектор) и определена вероятность $P_{\beta e}$ регистрации β -детектором электронов, рассеянных из MCP-детектора. На основании этого, по приведенным после таблицы соотношениям, определен выход e_0 -электронов от "встряски" Z_{Sh} на акт β -распада ^{152}Eu . Другим важным результатом измерений с ^{152}Eu , который используется в измерениях с ^{154}Eu , является то, что рассеяние из детектора в детектор слабо зависит от различных конфигураций в геометрии измерения и становится значительным только при энергиях β -частиц выше 700 кэВ. Как можно видеть из табл. 1, в измерениях с сеткой и без внешнего источника образования e_0 -электронов, каковым является экран El, выход e_0 -электронов от поверхности источника в $\gamma\beta e_0$ -совпадениях выше в среднем в два раза, чем в γe_0 -совпадениях (см. измерения 3 и 7). Как следует из оценок и непосредственных измерений с источником ^{154}Eu (см. раздел 2.3), образованием e_0 -электронов от β -частиц в поверхности источника ^{152}Eu толщиной активного слоя $\sim 10 - 20$ мкг · см $^{-2}$ можно пренебречь и, таким образом, нельзя это увеличение связать с выделением направления образования. Все указывает на наличие корреляции направления вылета β -частицы и e_0 -электрона от "встряски", а значит и самого электрона "встряски", при которой β -частица и электрон "встряски" должны испускаться в одну полусферу, поскольку в эту же полусферу испускается e_0 -электрон. На это указывают и измерения 5 и 6, поскольку увеличение e_0 -выхода при $\gamma\beta e_0$ -совпадениях в этом случае нужно связывать еще и с экраном El, на котором образование e_0 -электронов от низкоэнергетичных электронов "встряски" должно происходить с большей вероятностью, чем от β -частиц.

2.3. Результаты измерений с ^{154}Eu

Фрагмент экспериментального спектра совпадений γ -квантов с β -частицами и электронами (электроны “встряски”, e_0 -электроны) для ^{154}Eu приведен на рис. 3. Пунктиром на нем, как и на предыдущем рисунке без указания экспериментального разброса, приведен спектр $\gamma\beta$ -совпадений, на который делятся скорректированные на случайный фон и дополнительные составляющие от конверсии спектры $\gamma\beta e_0$ - и $\gamma\beta e_0$ -совпадений для получения выхода e_0 -электронов от “встряски” и выхода самих электронов “встряски” на акт β -распада. Левый пик совпадений с $\gamma 996$ кэВ, в отличие от совпадений с $\gamma 1005$ кэВ и другими выбранными в измерениях γ -переходами, не содержит вклад в e_0 -компонент от конверсии каскадного перехода $\gamma 123$ кэВ, поскольку происходит на основное состояние ^{154}Gd . По этой причине этот пик спектра совпадений $\gamma 996\beta 249(e + e_0)$ содержит (за исключением 26 % фона

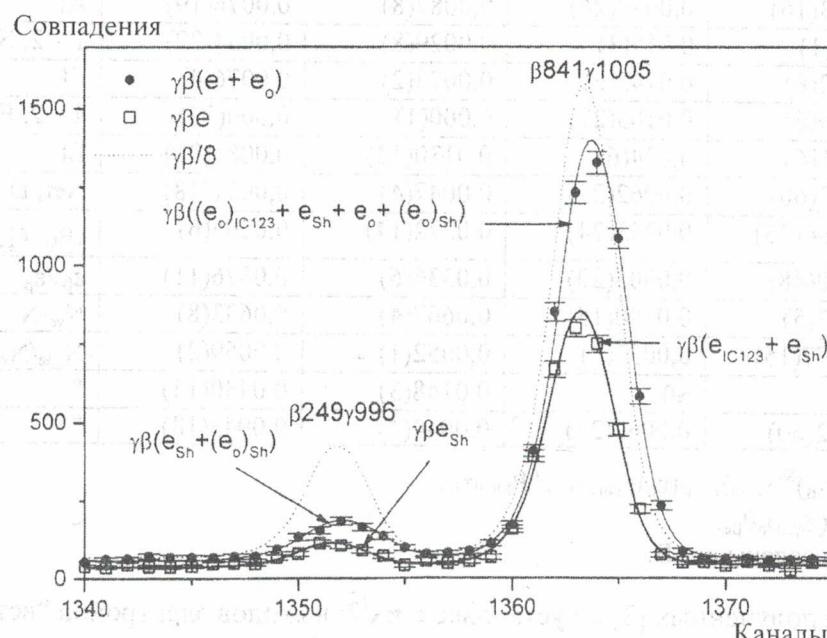


Рис. 3. $\gamma\beta(e + e_0)$ -совпадения в распаде ^{154}Eu .

(плюс 26 % фона от случайных совпадений) только совпадения с электронами “встряски” и e_0 -электронами от “встряски”. Основные результаты по ^{154}Eu приведены в табл. 2. В ней для основных β -компонент ^{154}Eu и всего β -спектра ^{152}Eu , присутствующего в источнике как примесь, представлены полные Z -выходы e_0 -электронов на акт β -распада и Z -выходы e_0 -электронов только от “встряски”. Результаты получены из измерения γ -, $\gamma\beta$ -, γe_0 - и $\gamma\beta e_0$ -спектров в различных геометриях окружения источника (сетка Net, экран El), при различных потенциалах на источнике, экране и сетке и таким образом относятся либо ко всей геометрии измерений вместе с источником, либо к обратной стороне подложки источника (индекс b), либо к экрану El (индекс El), либо к поверхности источника (индекс sf). Вычитание вклада от внутренней конверсии перехода $\gamma 123$ выполнено с учетом разрядки соответствующих состояний [4] по следующим соотношениям:

$$Z_{\text{IC}123} = Z_{\gamma 873} - Z_{\gamma 996}; \quad Z_{\beta 249} = Z_{\gamma 723} - 0.537 Z_{\text{IC}123}; \quad Z_{\beta 571} = Z_{\gamma 723} - Z_{\text{IC}123}; \quad Z_{\beta 841} = Z_{\gamma 723} - Z_{\text{IC}123}.$$

Главными определяемыми величинами являются Z -выходы e_0 -электронов (и Z_{sh} выходы от “встряски” как части) для поверхности источника и экрана El, рассматриваемые отдельно в измерениях γe_0 - и $\gamma\beta e_0$ -совпадений. В случае отсутствия корреляции β -частица-электрон “встряски” эти величины для части от “встряски” должны совпадать, а при ее отсутствии – нет. Определенные по совокупности данных, из необходимых разностей и

усреднения, основные результаты по Z-выходам при β -распаде из γe_0 - и $\gamma \beta e_0$ -совпадений для поверхности источника и экрана EI приведены в пунктах табл. 2 под № 11, 12 и 6, 13. Для выделения части от "встряски" нужно учесть вклад в образование e_0 -электронов от β -частиц, поскольку такое образование e_0 -электронов из-за значительной толщины активного слоя источника ^{154}Eu должно иметь место. В качестве такого вклада взято значение выхода e_0 -электронов от β -частиц, проходящих через подложку в геометрии "down", электрически сходной с геометрией "up" для поверхности источника, когда электрического поля нет. Это значение, взятое из измерений $\gamma 1274$ - e_0 совпадений на установке с $\pi\sqrt{2}$ и по эффективности регистрации MCP-детектором соответствующее установке с $\gamma \beta e_0$ -измерениями, составляет 0,0028(4). Поправленные на эту величину значения выхода e_0 -электронов от "встряски" из измерений γe_0 - и $\gamma \beta e_0$ -совпадений приведены в двух последних строчках табл. 2. Рассматривая статистически точный результат по компоненте $\beta 249$, можно видеть, что Z-выход e_0 -электронов из $\gamma \beta e_0$ -совпадений в два раза выше, чем из γe_0 -совпадений, однозначно указывая тем самым на наличие корреляции в направлении вылета β -частицы, e_0 -электрона и образующего его электрона "встряски", испытывающих преимущественное испускание в одну полусферу. Этот вывод подтверждается Z-выходами e_0 -электронов от электрода EI в γe_0 - и $\gamma \beta e_0$ -совпадениях, когда получаемые значения (см. п. 6, 13) отличаются уже в четыре раза и учет значения 0,0028(4) от β -частиц это различие делает еще большим.

Таблица 2. Выходы e_0 -электронов Z при β -распаде и e_0 -электронов от "встряски" Z_{Sh} на акт β -распада в γe_0 - и $\gamma \beta e_0$ -совпадениях при β -распаде ^{154}Eu

№, эксперимент	$\beta 249$ ($\gamma 723$)	$\beta 571$ ($\gamma 1274$)	$\beta 841$ ($\gamma 1005$)	$\beta^{152}\text{Eu}$ ($\gamma 344$)	Геометрия измерений
1. γe_0	0,0381(7)	0,0205(11)	0,0183(12)	0,020(7)	EI
2. $(\gamma e_0)_b$	0,0172(8)	0,0074(15)	0,0052(15)	0,00(2)	EI, Net
3. $(\gamma e_0)_e$	0,0085(9)	0,0027(15)	0,0042(15)	0,00(1)	EI
4. $(\gamma e_0)_{sf}$	0,0124(14)	0,0104(24)	0,0089(24)	0,020(7)	1 – 2 – 3, EI
5. $(\gamma e_0)_e$	0,0091(11)	0,0046(18)	0,0016(18)	0,009(11)	1 – 8, EI
6. $(\gamma e_0)_e$	0,0087(7)	0,0035(12)	0,0031(12)	0,005(6)	Среднее 3, 5
7. $\gamma \beta e_0$	0,0582(79)	0,026(10)	0,024(10)	0,00(2)	EI
8. γe_0	0,0290(9)	0,0159(14)	0,0167(14)	0,011(8)	Net
9. $(\gamma e_0)_b$	0,0172(8)	0,0074(15)	0,0052(15)	0,00(2)	Net, EI
10. $(\gamma e_0)_{sf}$	0,0118(12)	0,0085(20)	0,0115(20)	0,011(16)	8 – 9, Net
11. $(\gamma e_0)_{sf}$	0,0121(9)	0,0093(15)	0,0104(15)	0,019(6)	Среднее 4, 10
12. $\gamma \beta e_0$	0,0219(37)	0,0094(50)	0,0114(51)	0,03(2)	Net
13. $(\gamma \beta e_0)_e$	0,0363(87)	0,016(11)	0,013(12)	0,00(3)	7 - 12 EI
14. $(Z_{\gamma e_0})_{Sh}$	0,0090(12)	0,0057(20)	0,0087(20)	0,018(8)	$11 - (Z_\beta)_{sf}^*$
15. $(Z_{\gamma \beta e_0})_{Sh}$	0,0163(37)	0,0038(50)	0,0058(51)	0,03(2)	$12 - 2(Z_\beta)_{sf}^*$

* $(Z_\beta)_{sf} = 0,0028(4)$ из $\gamma 1274$ - e_0 -совпадений ("down").

Все энергии приведены в кэВ.

Из-за наличия совпадений β -частиц с конверсионными электронами от $\gamma 123$ кэВ, являющихся для наблюдения "встряски" фоновыми, выход электронов "встряски" при β -распаде ^{154}Eu из измерений $\gamma \beta e_0$ -совпадений определен только для смеси компонент $\beta 249 + 0,17\beta 972$ при отборе $\gamma 996$ кэВ и приводится в табл. 3.

3. Обсуждение результатов и выводы

Основные результаты проведенных в данной работе исследований по "встряске" при β -распаде ^{152}Eu и ^{154}Eu приведены табл. 3, в которой для основных компонент β -спектров

Таблица 3. Сравнительная таблица выхода электронов “встряски” и e_0 -электронов от “встряски” на акт β -распада ^{152}Eu и ^{154}Eu

Величина	Компонент				Методика измерений
	$\beta 175\ ^{152}\text{Eu}$ ($\gamma 1299$)	$\beta 384\ ^{152}\text{Eu}$ ($\gamma 1090$)	$\beta 695\ ^{152}\text{Eu}$ ($\gamma 779$)	$\beta 1063\ ^{152}\text{Eu}$ ($\gamma 411$)	
$(P_\beta)_{Sh}$	0,0268(31) (0,0265(80))	0,0194(13) (0,0225(15))	0,0223(4) (0,0173(9))	0,0239(7) (0,0129(4))	$\gamma\beta e_0$, $(\pi\sqrt{2})$
Z_{Sh}	0,0372(60) 0,013(1)	0,0062(27) 0,015(3)	0,0047(4) 0,0029(3)	0,0051(18) 0,0034(22)	$\gamma\beta e_0$ γe_0
Величина	Компонент				Методика измерений
	$\beta 249\ ^{154}\text{Eu}$ ($\gamma 723$) ($\gamma 996$)	$\beta 571\ ^{154}\text{Eu}$ ($\gamma 1274$)	$\beta 841\ ^{154}\text{Eu}$ ($\gamma 1005$)	$\beta\ ^{152}\text{Eu}$ ($\gamma 344$)	
Z_{Sh}	0,0163(37) 0,019(4) 0,0090(20) 0,0363(87) 0,0087(7)	0,0038(50) 0,0057(20) 0,016(11) 0,0035(12)	0,0058(51) 0,0087(20) 0,013(12) 0,0031(12)	0,03(2) 0,0018(8) 0,00(3) 0,005(6)	$\gamma\beta e_0$ $\gamma\beta e_0$ γe_0 $(\gamma\beta e_0)_e$ $(\gamma e_0)_e$
$(P_\beta)_{Sh}$	0,013(2)* ($\gamma 996$)				$\gamma\beta e_0$

* Пересчитан к геометрии $\pi\sqrt{2}$.

Все энергии приведены в кэВ.

приведены значения выхода электронов “встряски” и e_0 -электронов от “встряски” на акт β -распада. Можно видеть, что полученные значения выхода электронов “встряски” для ^{152}Eu хорошо согласуются с предыдущими результатами [3], указывая при этом на величину поправки при учете ложной регистрации от рассеяния из детектора в детектор. Выход $(P_\beta)_{Sh}$ электронов “встряски”, как и выход e_0 -электронов Z_{Sh} у ^{154}Eu меньше, чем у ^{152}Eu , что соответствует большей толщине активного слоя ^{154}Eu , препятствующей вылету низкоэнергетичных электронов из среды источника. Из таблицы можно видеть, что Z_{Sh} -выходы e_0 -электронов от поверхности источников, и особенно от экрана EI, на $\gamma\beta e_0$ -совпадениях в несколько раз выше, чем на γe_0 -совпадениях. Следует еще раз подчеркнуть, что это нельзя объяснить образованием e_0 -электронов в поверхности источника от β -частиц, поскольку непосредственные измерения их выхода дают значение 0,0028(4) для источника ^{154}Eu (для более тонкого источника ^{152}Eu примерно вдвое меньше), составляющее малый вклад в общий выход e_0 -электронов на акт β -распада. Кроме того, результаты измерений для $\beta 695$ кэВ, выполненные в геометриях “up” и “down” [8], показывают, что интенсивность компонента от “встряски” из источника ^{152}Eu велика, поскольку основным источником образования e_0 -электронов от электрода EI при β -распаде является низкоэнергетичный компонент, которым могут быть только электроны “встряски”. По данным работы [9] компонент “встряски” от β -распада, создающий e_0 -электроны, покидающие измеряемый источник ^{152}Eu , также значителен. Не лишним будет также отметить, что оценка вероятности образования e_0 -электронов из среды от β -частиц, к которой можно подойти на основании данных о первичной ионизации [10], не может привести к большой величине, поскольку расстояние между актами ионизации составляет 300 Å, а расстояние между точками образования δ -электронов (>100 эВ), которые могут быть ответственны за образование и вылет e_0 -электронов из среды, составляет 10^4 Å, в то время как толщина источника ^{152}Eu не

превышает 100 Å; причем еще нужно учесть вероятность вылета электрона вторичной эмиссии, которая мала. Все это вместе не позволяет считать образование e_0 -электронов от "встряски" при β -распаде малым и не ответственным за полученные результаты. Увеличение выхода e_0 -электронов на $\gamma\beta e_0$ -совпадениях в несколько раз по сравнению с γe_0 -совпадениями после вычитания компонента от собственно β -частиц можно объяснить только наличием корреляции β -частицы с e_0 -электроном и, как следствие, с электроном "встряски", поскольку e_0 -электрон от него и образовался. Таким образом, это указывает на корреляцию β -частица – электрон "встряски". Рис. 4 наглядно объясняет ситуацию в отношении корреляции направлений и в отношении больших Z_{Sh} -величин на $\gamma\beta e_0$ -совпадениях.

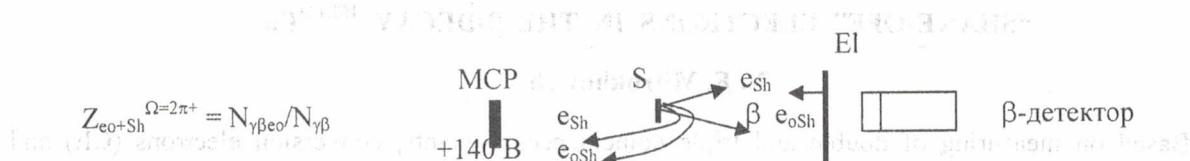


Рис. 4. Собирание MCP-детектором низкоэнергетических электронов "встряски" e_{Sh} и e_{oSh} -электронов от "встряски" с поверхности источника и электрода EI при отборе совпадений с β -частицами, когда и электроны "встряски" (e_{Sh}), и e_{oSh} -электроны принадлежат той же полусфере, что и β -частица.

Это все вместе указывает на то, что электрон "встряски" при β -распаде испускается преимущественно в ту же полусферу, что и β -частица, которая его вызывает. Такой вывод находится в согласии с недавними результатами [5 - 7] по двойной фотоионизации в процессе (γ , 2e), схожему со "встряской" при β -распаде, которые показывают, что оба электрона сильно скоррелированы по направлению вылета, испускаясь в одну полусферу. Хотя совпадение результатов и обращает на себя внимание, нельзя все же сказать, что главные механизмы, ответственные за корреляции в этих процессах, будут существенно одинаковыми, несмотря на то, что механизм "встряски" (shake-off) присутствует в той или иной мере и при β -распаде, и при фотоионизации (двойная фотоионизация).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Матвеев В. И., Парилis Э. С. Встряска при электронных переходах в атомах // Успехи физических наук. - 1982. - Т. 138, вып. 4. - С. 573 - 602.
2. Митрохович Н. Ф. Учет эффектов "встряски" от бета-распада при определении коэффициентов внутренней конверсии по вторичному электронному излучению// Зб. наук. праць Ін-ту ядерних дослід. - 2002. - № 2(8) - С. 70 - 74.
3. Митрохович Н.Ф. Электроны "встряски" при β -распаде ^{152}Eu // Там же. – 2003. - № 1 (9). - С. 24 - 31.
4. Firestone R.B. et al. Table of isotopes, CD-ROM edition, 1996.
5. Weber TH, Giessen H, Weckenbrock M. et al Correlated electron emission in multiphoton double ionization // Nature. - 2000. - Vol. 405. - P. 658 - 661.
6. Weckenbrock M, Hattas M, Gzasch M. et al Experimental evidence for electron repulsion in multiphoton double ionization // J. Phys. B.: At. Mol. Opt. Phys. - 2001. - Vol..34. - P. L449 - L455.
7. Moshammer R., Ulrich J., Fisher D. Strongly directed electron emission in non-sequential double ionization of Ne by intense laser pulses // J. Phys. B.: At. Mol. Opt. Phys. - 2003. - Vol.36. - P. L113 - L119.
8. Митрохович Н. Ф. Исследование вторичных электронов от радиоактивного излучения в источниках $^{152}1546155\text{Eu}$ и ^{153}Gd в различных экспериментальных условиях // Зб. наук. праць Ін-ту ядерних дослід. - 2001. - № 2(4). - С. 45 - 52.
9. Куприякін В. Т., Сидоренко Л. П., Феоктистов О. І., Шаповалова І. П. Дослідження залежності виходу електронів близьконульової енергії від товщини джерела для різних видів радіоактивного розпаду // УФЖ. - 2000. - Т. 45, № 8. - С. 918 - 921.
10. Медведев М. Н. Сцинтиляционные детекторы. - М.: Атомиздат, 1977. - С. 19

ЗАПІДНІЙ ВІДСІК ЕЛЕКТРОНИ "СТРУСУ" ПРИ β -РОЗПАДІ $^{152,154}\text{Eu}$ **М. Ф. Митрохович**

На основі проведених вимірювань подвійних і потрійних збігів γ -квантів, конверсійних електронів (CE) і β -частинок з електронами (включаючи вторинно-емісійні e_o -електрони близьконостіової енергії - збіги (γ , CE)-(e, e_o) і збіги $\gamma\beta e_o$ - вимірюно вихід e_o -електронів від "струсу" на акт β -розпаду $^{152,154}\text{Eu}$ для різних компонент β -спектрів $^{152,154}\text{Eu}$. Установлено, що при β -розпаді $^{152,154}\text{Eu}$ β -частинки та електрони "струсу", що викликаються ними і створюють e_o -електрони, скорельовані по напряму руху, зазнаючи переважного вильоту в одну напівсферу.

"SHAKE-OFF" ELECTRONS IN THE β -DECAY $^{152,154}\text{Eu}$ **N. F. Mitrokhovich**

Based on measuring of double and triple coincidences γ -quants, conversion electrons (CE) and β -particles with electrons (including the e_o -electrons of secondary electron emission - coincidence (γ , CE)-(e, e_o) and coincidence $\gamma\beta e_o$) the output of e_o -electrons is measured per on act β -decays $^{152,154}\text{Eu}$ for different components of the β -spectrum. In the β -decay is established that β -particles and shake-off electrons (observed by e_o -electrons), which are caused by them are correlated in the direction of light, demonstrating predominantly emitting to the same half sphere.

Поступила в редакцію 20.02.04,
после дороботки – 25.06.04.

Короткий зміст цієї праці: викладено результати вимірювань збігів γ -квантів, конверсійних електронів (CE) і β -частинок з електронами (включаючи вторинно-емісійні e_o -електрони близьконостіової енергії - збіги (γ , CE)-(e, e_o) і збіги $\gamma\beta e_o$ - вимірюно вихід e_o -електронів від "струсу" на акт β -розпаду $^{152,154}\text{Eu}$ для різних компонент β -спектрів $^{152,154}\text{Eu}$). Установлено, що при β -розпаді $^{152,154}\text{Eu}$ β -частинки та електрони "струсу", що викликаються ними і створюють e_o -електрони, скорельовані по напряму руху, зазнаючи переважного вильоту в одну напівсферу.

ІНДИКАТОРНЕ ПОДІЛЕННЯ

Всеукраїнський конкурс молодих наукових робітників та аспірантів з фундаментальних та прикладних дисциплін, що мають позитивний вплив на розвиток науки та промисловості, відбувається з 1992 року. Це єдиний в Україні конкурс, який об'єднує всі види наукової діяльності та сприяє підвищенню рівня наукової та методичної кваліфікації молодих наукових кадрів та підвищенню рівня освіти та кваліфікації підготовчих вузів та інститутів.

Це єдиний конкурс, який об'єднує всі види наукової діяльності та сприяє підвищенню рівня наукової та методичної кваліфікації молодих наукових кадрів та підвищенню рівня освіти та кваліфікації підготовчих вузів та інститутів. Це єдиний конкурс, який об'єднує всі види наукової діяльності та сприяє підвищенню рівня наукової та методичної кваліфікації молодих наукових кадрів та підвищенню рівня освіти та кваліфікації підготовчих вузів та інститутів.

Це єдиний конкурс, який об'єднує всі види наукової діяльності та сприяє підвищенню рівня наукової та методичної кваліфікації молодих наукових кадрів та підвищенню рівня освіти та кваліфікації підготовчих вузів та інститутів.